

● 硅 NPN 外延平面管

● 用途:

高频放大/振荡/混频

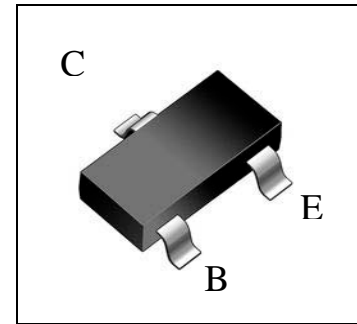
● 特点:

高传输频率 f_T ;

低输出电容 C_{ob} 、 C_{rb} ;

● 极限参数($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	单位	规范值
耗散功率	P_{tot}	mW	200
集电极电流	I_c	mA	50
结温	$T(j)$	$^\circ\text{C}$	125
存贮温度	T_{stg}	$^\circ\text{C}$	-55~+125
集电极-基极电压	V_{CBO}	V	20
集电极-发射极电压	V_{CEO}	V	10
发射极-基极电压	V_{EBO}	V	3



Package: SOT-323

Marking Symbol: N2t

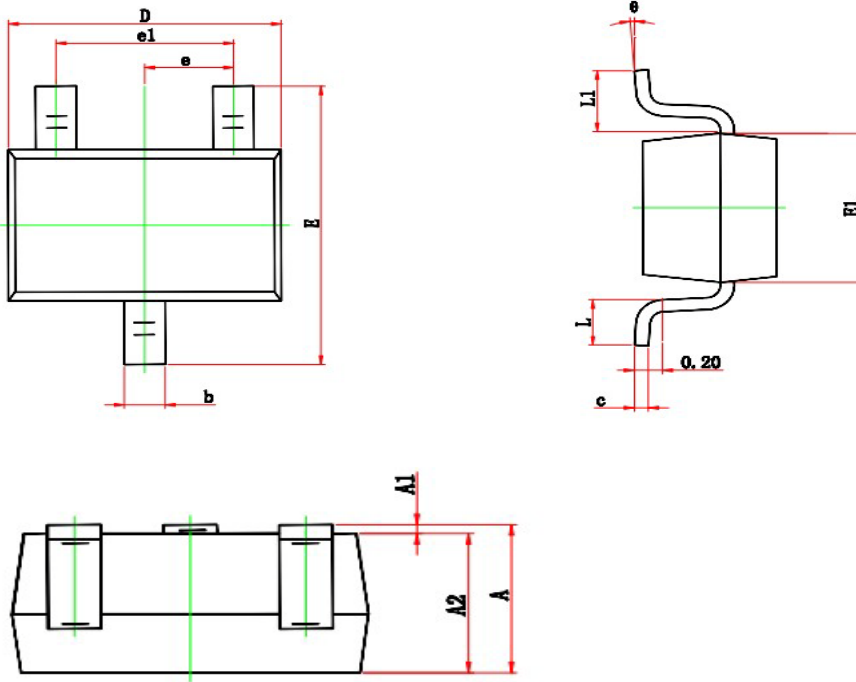
● 电参数($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	测试条件	最小值	最大值	单位
I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{V}$ $I_{MAX}=10\ \mu\text{A}$		1.0	μA
I_{CEO}	$V_{CE}=8.0\text{V}$ $I_{MAX}=1\ \mu\text{A}$		5.0	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=2.0\text{V}$ $I_{MAX}=500\ \mu\text{A}$		100	μA
H_{FE}	$V_{CE}=6\text{V}$ $I_C=5\ \text{mA}$	80	300	
f_T	$V_{CE}=10\text{V}$ $I_C=20\text{mA}$	TYP: 8.5		GHz
C_{ob}	$V_{CB}=5\text{V}$ $f=1\text{MHz}$	TYP: 1.0		pF
$ S_{21} ^2$	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=10\text{mA}$ $f=1.0\text{GHz}$	TYP: 13.9		dB
NF	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=5\text{mA}$ $f=1.0\text{GHz}$	TYP: 1.4		dB

● H_{FE} 分档

Rank	B	C	D	E
H _{FE}	80~120	120~180	180~240	240~300

● DIMENTION SOT-323 外形封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.900	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.000	0.035	0.039
b	0.200	0.400	0.008	0.016
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.000	2.200	0.079	0.087
E	2.150	2.450	0.085	0.096
E1	1.150	1.350	0.045	0.053
e	0.650 TYP.		0.026 TYP.	
e1	1.200	1.400	0.047	0.055
L	0.260	0.460	0.010	0.018
L1	0.525 REF.		0.021 REF.	
θ	0°	8°	0°	8°